



一种制备三维环栅结构半导体场效应晶体管器件的方法

专利名称: 一种制备三维环栅结构半导体场效应晶体管器件的方法
专利类别: 发明
申请号: 2015107085039
第一发明人: 顾长志
其它发明人: 郝婷婷;李无瑕;李俊杰
专利授权日期: 2019-08-23

[关闭窗口](#)

